



(19) BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENT- UND

MARKENAMT

(12) Offenlegungsschrift

(10) DE 101 21 132 A 1

(51) Int. Cl. 7:

H 01 L 21/3205

H 01 L 21/8242

(21) Aktenzeichen: 101 21 132.5
 (22) Anmeldetag: 30. 4. 2001
 (43) Offenlegungstag: 31. 10. 2002

(71) Anmelder:

Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

(74) Vertreter:

PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner, 80801
München

(72) Erfinder:

Sell, Bernhard, 01099 Dresden, DE; Hecht, Thomas,
01099 Dresden, DE; Sänger, Annette, 01099
Dresden, DE

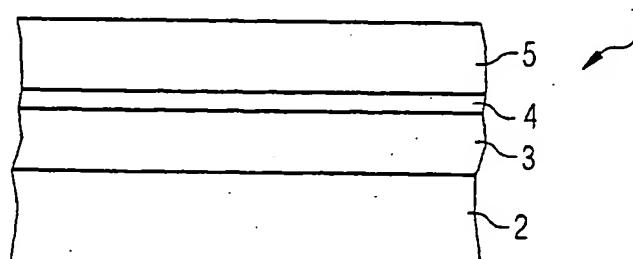
(56) Entgegenhaltungen:

DE	198 53 598 A1
DE	198 20 147 A1
US	61 44 060
US	61 39 700

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Präkursors auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht, insbesondere eines elektronischen Bauelements

(57) Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Präkursors auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht insbesondere eines elektronischen Bauelements, bei dem auf die silizium- oder germaniumhaltige Schicht vor der Verwendung des Präkursors eine Zwischenschicht aufgebracht wird, die zumindest für die Elemente des Präkursors, die die silizium- oder germaniumhaltige Schicht ätzen würden, eine Diffusionsbarriere bildet und selbst gegenüber dem Präkursor ätzresistent ist.



DE 101 21 132 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder metalzhaltigen Schicht unter Verwendung eines Präkursors auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht insbesondere eines elektronischen Bauelements.

[0002] Zum Abscheiden von Metallen auf silizium- oder germaniumhaltigen Substanzen werden häufig Präkursoren, vornehmlich flourhaltige Präkursoren verwendet. Diese Abscheidetechnik ist hinlänglich bekannt. Nachteilig hierbei ist jedoch, dass manche der hierbei verwendeten Präkursoren, insbesondere die flourhaltigen Präkursoren mit der silizium- oder germaniumhaltigen Substrat- oder Waferoberfläche reagieren. Bei siliziumhaltigen Substraten entsteht bei Verwendung eines flourhaltigen Präkursors z. B. flüchtiges SiF₄. Das Substrat wird dabei angeätzt. Sowohl bei der Abscheidung der metallischen oder metalzhaltigen Schicht oder Struktur als Metallelektrode für Gates oder Kondensatoren als auch bei der Abscheidung dieser Schicht für Kontaktlochfüllungen führt dies zur Zersetzung der Struktur und damit des elektronischen Bauelements, welches unter Verwendung dieser Schichtstruktur gebildet werden soll.

[0003] Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das die Erzeugung einer metallischen oder metalzhaltigen Schicht unter Verwendung eines Präkursors ohne die eingangs genannten Nachteile ermöglicht.

[0004] Zur Lösung dieses Problems ist ein Verfahren der eingangs genannten Art vorgesehen, bei dem auf die silizium- oder germaniumhaltige Schicht vor der Verwendung des Präkursors eine Zwischenschicht aufgebracht wird, die zumindest für die Elemente des Präkursors, die die silizium- oder germaniumhaltige Schicht ätzen würden, eine Diffusionsbarriere bildet und selbst gegenüber dem Präkursor ätzresistent ist.

[0005] Das vorliegende erfindungsgemäße Verfahren schlägt vorteilhaft eine der eigentlichen Schichterzeugung vorausgehende Oberflächenbehandlung der silizium- oder germaniumhaltigen Schichtoberfläche durch Aufbringen einer dünnen Zwischenschicht vor, die die Oberfläche der darunter liegenden Schicht gegen den Angriff der Präkursoren schützt und das Substrat zumindest in dem Bereich, wo der Präkursor angreifen kann, versiegelt. Erfindungsgemäß handelt es sich dabei um eine Schicht, die als Diffusionsbarriere für diejenige chemische Spezies des Präkursors wirkt, welche die Silizium- oder Germaniumätzung verursacht. Weiterhin ist die verwendete Schicht gegenüber dem Angriff der Präkursoren ätzresistent, d. h., sie wird selbst nicht angeätzt. Nach dem Aufbringen dieser "Siegschicht" kann die eigentliche Schichterzeugung problemlos erfolgen, eine Beeinträchtigung der silizium- oder germaniumhaltigen Schicht, die unter der sehr dünnen Zwischenschicht liegt, ist ausgeschlossen. Für die Metallabscheidung können somit die zur Schichtabscheidung bereits bewährten Präkursoren verwendet werden, ohne dass eine Beeinflussung oder Zersetzung der zu erzeugenden Schichtstruktur oder des Bauelements zu besorgen ist. Weiterhin kann auf bekannte Abscheidetechniken und -tools zurückgegriffen werden, was die Herstellungskosten stark reduziert.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht z. B. die Abscheidung von Metallelektroden auf dünnen Silizium oder Germanium enthaltenden Dielektrika unter Verwendung der Präkursoren. So kann z. B. auf Gate-Oxiden eine sehr dünne Zwischenschicht abgeschieden werden, um anschließend die Metallabscheidung vorzunehmen. Auf diese Weise können die guten Grenzflächeneigenschaften zwischen SiO₂ und dem Substrat bzw. der Bottom-Elektrode bei

Verwendung von Metallelektroden beibehalten werden, wenn als Schichtstruktur bzw. Bauelement z. B. eine Kondensatorstruktur hergestellt werden soll.

[0007] Eine andere zweckmäßige Einsatzmöglichkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt in der Kontaktlochfüllung. Hier kann, da zur Ermöglichung der Metallschichtabscheidung lediglich die sehr dünne Zwischenschicht erforderlich ist, die Leitfähigkeit des Kontakts zum darunter liegenden Material deutlich verbessert werden.

[0008] Um zu verneinen, dass die Zwischenschicht in irgendeiner Form die Funktionsweise der Schichtstruktur und damit des elektronischen Bauelements beeinflusst ist es zweckmäßig, wenn sie extrem dünn aufgebracht wird. Die Dicke der Zwischenschicht sollte dabei lediglich wenige Atomlagen betragen. Die Dicke sollte im nm-Bereich liegen. Besonders bevorzugt wird dabei die Abscheidung der Zwischenschicht in einem ALD-Verfahren (Atomic Layer Deposition). Mit diesem Verfahren abgeschiedene Schichten garantieren eine sehr gute Schichtuniformität mit extrem niedriger Defektdichte sowie eine exzellente Kantenabdeckung, wobei diese Eigenschaften insbesondere für die Füllung von Kontaktlöchern bzw. die Abscheidung von Metallelektroden in Grabenkondensatoren wesentlich ist. Darüber hinaus bietet die Abscheidung der Zwischenschicht in einem ALD-Verfahren die Möglichkeit der exakten Schichtdickenkontrolle.

[0009] Als Zwischenschicht sollte zweckmäßigerweise ein Dielektrikum verwendet werden, wofür sich z. B. Al-, Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxide eignen. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass eine temperaturstabile Zwischenschicht verwendet wird, die gegenüber nachfolgenden, entweder im Rahmen der Erzeugung der eigentlichen metallischen oder metalzhaltigen Schicht oder danach folgenden Temperaturschritten stabil bleibt. Dies ist insbesondere zweckmäßig, wenn wie vorgesehen die Zwischenschicht in einem ihrer Abscheidung nachfolgenden Hochtemperaturschritt stabilisiert wird.

[0010] Zweckmäßig ist es ferner, wenn eine Zwischenschicht verwendet wird, die eine Diffusion im Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen oder metalzhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozesses ermöglicht. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt die Schichterzeugung durch Abscheidung einer Metallschicht auf der Zwischenschicht und einem anschließenden Diffusionsprozess zur Silizierung des abgeschiedenen Metalls, was hinreichend bekannt ist. Da die Diffusion der beteiligten Komponente(n) durch die Zwischenschicht erfolgt, muss diese zwangsläufig für die diffundierenden Komponenten diffusionsoffen sein.

[0011] Neben der Verwendung einer temperaturstabilen Schicht bietet sich auch die Verwendung einer temperaturinstabilen Schicht an, die sich in einem nachfolgenden, gegebenenfalls weiteren Temperaturschritt, insbesondere im Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen oder metalzhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozesses zerstellt. Ist die Metallschicht unter Verwendung des Präkursors einmal aufgebracht, so wird die Zwischenschicht, der dann die Funktion einer Opferschicht zukommt, nicht unbedingt mehr benötigt. Schließt sich beispielsweise ein Silizid-Prozess an, so kann die extrem dünne Zwischenschicht innerhalb dieses Prozesses aufgebrochen werden und sich durch die auf ihr abgeschiedene Metallschicht ohne Beeinträchtigung der Funktion der Schichtstruktur verflüchten.

[0012] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren betrifft die Erfindung ferner ein elektronisches Bauelement, umfassend eine silizium- oder germaniumhaltige Schicht und eine nach dem erfindungsgemäßen beschriebenen Verfahren auf der silizium- germaniumhaltigen Schicht hergestellte metal-

lische oder metallhaltige Schicht.

[0013] Das erfundungsgemäße Bauelement zeichnet sich des Weiteren dadurch aus, dass die Zwischenschicht eine Dicke von wenigen Atomlagen aufweist, also sehr dünn ist und zweckmässigerweise in einem ALD-Verfahren aufgebracht ist. Die Zwischenschicht sollte zweckmässigerweise ein Dielektrikum bevorzugt aus einem Al-, Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxid sein und vorzugsweise in einem Temperaturschritt stabilisiert sein.

[0014] Schließlich kann vorgesehen sein, dass sich die metallische oder metallhaltige Schicht oberhalb, unterhalb oder beiderseits der Zwischenschicht befindet. Die beiderseitige Schichtausbildung kann insbesondere im Rahmen eines Silizid-Prozesses aufgrund der hierbei gegebenen Diffusionsvorgänge erfolgen.

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 einen ersten erfundungsgemäßen Schichtaufbau zur Bildung einer Transistorstruktur,

[0017] Fig. 2 einen zweiten erfundungsgemäßen Schichtaufbau zur Bildung einer Kondensatorstruktur,

[0018] Fig. 3 eine Prinzipskizze zur Darstellung der Herstellung einer Kontaktlochstruktur einer ersten Ausführungsform,

[0019] Fig. 4 eine Prinzipskizze zur Darstellung der Herstellung einer Kontaktlochstruktur einer zweiten Ausführungsform, und

[0020] Fig. 5a, 5b, 5c Prinzipskizzen zur Darstellung einer Deep-Trench-Bottomelektrode durch Silizid-Bildung.

[0021] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines erfundungsgemäßen Bauelements 1 einer ersten Ausführungsform als Prinzipskizze. Bei diesem Ausführungsbeispiel soll eine Transistorstruktur mit einem Gate-Dielelektrikum und Metallelektrode realisiert werden. Hierzu wird auf einem Substrat 2, z. B. Bulk-Si in einem standardmässigen CMOS-Prozess ein Gate-Dielelektrikum 3 erzeugt. Z. B. kann das Substrat zur Bildung von SiO₂ oxidiert oder ein Silikat abgeschieden werden, das dann das Gate-Dielelektrikum 3 bildet. Anschließend wird vorzugsweise in einem ALD-Prozess eine Zwischenschicht 4 auf das Gate-Dielelektrikum aufgebracht. Die Zwischenschicht 4 ist z. B. aus Al₂O₃ und ist zweckmässigerweise lediglich wenige Monolagen dick, da die Abscheidung in einem ALD-Prozess sehr defektarm durchgeführt und die Dicke sehr gut kontrolliert werden kann. Nachfolgend kann die Zwischenschicht 4 in einem Hochtemperaturschritt stabilisiert werden.

[0022] Nun folgt die Abscheidung der Gate-Elektrode 5 auf der Zwischenschicht 4. Beispielsweise kann es sich bei der Gate-Elektrode um ein wolframhaltiges Gate handeln, wobei WF₆ als Präkursor benutzt werden kann. Der WF₆-Präkursor kann deshalb verwendet werden, da die Zwischenschicht 4 das darunter liegende siliziumhaltige Gate-Dielelektrikum 3 "versiegelt". Die Zwischenschicht ist gegen die Fluor-Ionen des WF₆-Präkursors diffusionsdicht. Würde der WF₆-Präkursor direkt auf das Gate-Dielelektrikum 3 aufgebracht, so würde ein Ätzangriff unter Bildung von SiF₄ erfolgen und das Gate-Dielelektrikum 3 angeätzt werden. Dies wird durch die sehr dünne und defektarme Zwischenschicht 4 vorteilhaft verhindert, so dass derartige aggressive Präkureuren eingesetzt werden können. Daneben ist die Zwischenschicht 4 selbst gegenüber dem verwendeten Präkursor ätzresistent, d. h., sie wird selbst ebenfalls nicht angegriffen.

[0023] Als Gate-Elektrode 5 kann entweder W oder WN oder WSix unter Verwendung des Präkursors aufgebracht werden. Der nachfolgende CMOS-Prozess kann standardmäßig durchgeführt werden.

[0024] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfundungsgemäßen elektronischen Bauelements 6. Hierbei handelt es sich um eine Kondensatorstruktur, wie sie z. B. in einem Speicher kondensator eines DRAM eingesetzt wird.

5 Die Schichtstruktur bzw. das Bauelement 6 besteht aus einer Bottom-Elektrode 7, die entweder durch starkes Dotieren eines Substrats (z. B. Bulk-Si) gebildet wird, oder die durch zusätzliches Abscheiden von Metall geformt wird. Auf die Bottom-Elektrode 7 wird eine mehrlagige Schichtstruktur 8. 10 zur Bildung eines Node-Dielelektrikums aufgebracht. Dieses Dielektrikum besteht im gezeigten Ausführungsbeispiel aus einer Si₃N₄-Schicht 9 und einer auf dieser aufgebrachten SiO₂-Schicht 10. Auf die Schicht 10 wird anschließend die Zwischenschicht 11, auch hier z. B. aus Al₂O₃ in Form weniger Monolagen aufgebracht. Die Schichten 9, 10, 11 bilden zusammen das Node-Dielelektrikum. Auch hier erfolgt die Abscheidung der Schicht 11 bevorzugt in einem ALD-Prozess. Anschließend erfolgt die Abscheidung der oberen Metallschicht in Form der Metallelektrode 12, bei der es sich z. B. um eine wolframhaltige Elektrode, die unter Verwendung von WF₆ als Präkursor hergestellt wurde, handeln kann. Auch hier wird ein Angriff des aggressiven WF₆-Präkursors an der SiO₂-Schicht 10 durch Verwendung der extrem dünnen ätzresistenten Zwischenschicht 11 verhindert. 15 Diese kann auch hier optional durch einen vorhergehenden Hochtemperaturschritt stabilisiert worden sein. Die weitere Integration folgt nach dem bekannten Standardprozess.

[0025] Fig. 3 zeigt in Form einer Prinzipskizze ein weiteres Ausführungsbeispiel zur Herstellung einer Kontaktloch-

30 struktur eines Bauelements 13. Auf einem Substrat 14, bevorzugt aus Si wird zunächst eine Oxidschicht 15 erzeugt, in die anschließend Kontaktlöcher 16 geätzt werden. In die Kontaktlöcher 16 wird nachfolgend eine Zwischenschicht 17 sehr geringer Dicke (auch hier wiederum nur wenige 35 Atomlagen) in einem ALD-Prozess abgeschieden. Der ALD-Prozess ist hier insbesondere im Hinblick auf die extrem gute Kantenabdeckung der damit erzeugten Zwischenschicht 17 zweckmäßig. Nach Erzeugung der Zwischenschicht 17 werden die Kontaktlöcher 16 mit metallhaltigem 40 Material 18 gefüllt, z. B. mit WN mit WF₆ als Präkursor, das mittels eines CVD-Verfahrens abgeschieden wird. Es ergibt sich also auch hier der erfundungsgemäße Schichtaufbau mit der sehr dünnen, ätzresistenten Zwischenschicht 17. Auch hier erfolgt weder ein Angriff der SiO₂-Schicht 15 noch des 45 darunter liegenden siliziumhaltigen Substrats 14 durch den Präkursor, da dies durch die Zwischenschicht 17 verhindert wird. Ein weiterer Vorteil der mit dem ALD-Verfahren aufgebrachten sehr dünnen Zwischenschicht 17 ist darin zu sehen, dass wie ausgeführt die Schicht 17 extrem dünn abgeschieden werden kann, was für die Leitfähigkeit des Kontaktes vorteilhaft ist.

[0026] Nach dem Einbringen des WN-Materials 18 kann in einem nachfolgenden Anneal-Schritt der Stickstoff der WN-Schicht 18 ausgegast werden, so dass das Kontaktloch 50 letztendlich mit weitgehend stickstofffreiem W gefüllt ist.

[0027] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Bauelements 19, das ebenfalls eine Kontaktlochstruktur zeigt und wie auch das Bauelement 13 aus Fig. 3 aus einem zweckmässigerweise siliziumhaltigen Substrat 20 sowie ei-

60 ner aufgebrachten siliziumhaltigen Oxidschicht 21 besteht. Nach dem Ätzen der Kontaktlöcher 22 wird auch hier eine Zwischenschicht 23, vorzugsweise Al₂O₃ in einem ALD-Prozess aufgebracht. Anschließend wird das Kontaktloch zunächst mit einer sehr dünnen WN-Schicht 24 unter Verwendung eines WF₆-Präkursors auf der Zwischenschicht 23 abgeschieden, die als Diffusionsbarriere dient, wonach das Kontaktloch mit einer dicken Wolfram-Schicht 25 gefüllt wird. Auch ein solcher Schichtaufbau ist nur aufgrund der

Verwendung der extrem dünnen Zwischenschicht 23 möglich.

[0028] Schließlich zeigen die Fig. 5a, 5b und 5c ein weiteres erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Bauelements 26. Die Figuren beschreiben die Einführung einer Opferschicht bei der Silizid-Bildung einer Deep-Trench-Bottom-Elektrode des Bauelements 26. In ein vorzugsweise siliziumhaltiges Substrat 27 (gleichermaßen kann auch ein germaniumhaltiges Substrat verwendet werden, was bezüglich der vorbeschriebenen Ausführungsbeispiele gleichermaßen gilt) werden zunächst Gräben 28 geätzt, die anschließend mit einer sehr dünnen, wenige Monolagen dicken Zwischenschicht 29 wandseitig belegt werden. Bei der Zwischenschicht 29 kann es sich hier z. B. um Ta₂O₅ handeln. [0029] Auf die Zwischenschicht 29 wird nachfolgend eine metallische Schicht 30, z. B. aus Wolfram, abgeschieden. Auch hier verhindert die Zwischenschicht bei der nachfolgenden Abscheidung einer Metallschicht die Reaktion der verwendeten Präkursoren mit dem Substrat 27. In einem nachfolgenden Silizid-Prozess findet nun eine gleichzeitige Diffusion des Wolframs und des Siliziums durch die Zwischenschicht 29 statt, was – siehe Fig. 5a – dazu führt, dass sich auf beiden Seiten der Zwischenschicht 29 eine WSi_x-Schicht 31 diffusionsbedingt ausbildet. Anschließend kann, wie in Fig. 5c gezeigt, durch selektive Ätzung die obere Silizidschicht 31 abgeätzt werden, wobei in diesem Ätzprozess auch zusätzlich die Zwischenschicht 29 mit entfernt werden kann, so dass letztlich lediglich noch die ausgehend von Fig. 5b unterhalb der Zwischenschicht 29 befindliche Silizid-Schicht 31 verbleibt. Damit wird die Dicke der die Elektrode bildenden Metallschicht deutlich reduziert und der Durchmesser des Grabens wieder vergrößert. Anschließend erfolgt die Abscheidung des Node-Dielektrikums sowie der oberen Top-Elektrode und die weitere standardmäßige Integration.

[0030] Anstelle der in den Fig. 5a–5c gezeigten Ausführungsform ist es auch denkbar, anstatt einer temperaturinstabilen Zwischenschicht eine temperaturinstabile Schicht zu wählen, die sich im Rahmen des Silizid-Prozesses zerstört und dabei aufgebrochen wird und die sich durch die zuvor aufgebrachte Metallschicht verflüchtigt. Ein der Silizidbildung anschließender Ätzprozess dient schließlich lediglich noch zur Reduzierung der Silizidschicht.

[0031] Als Substrat, auf welches die Zwischenschicht und schließlich die metallhaltige und metallische Schicht aufzubringen ist, können alle silizium- oder germaniumhaltigen Schichten sowie deren Oxide, Nitride oder Carbide sowie Metallsilizide oder Metallsilikate, die jeweils ebenfalls Si-haltig sind, verwendet werden. Als die Zwischenschicht bildende Dielektrika können z. B. Al₂O₃, Ta₂O₅, HfO₂, TiO₂ oder ZrO₂ in diversen Stöchiometrien eingesetzt werden. Als Metalle sind alle hochschmelzenden Metalle sowie deren Nitride und Silizide wie W, Ti, Ta, Pd, Pt, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Co, Ni, Rh, RhO, Ir sowie andere Metalle wie Al, Cu, Ag, Fe verwendbar. Je nachdem, welches Metall oder welche metallische Schicht aufzubringen ist, wird der entsprechende Präkursor gewählt. Abhängig davon ist dann zweckmäßigerweise auch das jeweilige die Zwischenschicht bildende Dielektrikum hinsichtlich seiner diffusionsperrenden und ätzresistenten Eigenschaften zu wählen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen einer metallischen oder metallhaltigen Schicht unter Verwendung eines Präkursors auf einer silizium- oder germaniumhaltigen Schicht insbesondere eines elektronischen Bauelements, bei dem auf die silizium- oder germaniumhal-

tige Schicht vor der Verwendung des Präkursors eine Zwischenschicht aufgebracht wird, die zumindest für die Elemente des Präkursors, die die silizium- oder germaniumhaltige Schicht ätzen würden, eine Diffusionsbarriere bildet und selbst gegenüber dem Präkursor ätzresistent ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht in einer Dicke von wenigen Atomlagen aufgebracht wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht in einem ALD-Verfahren aufgebracht wird.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Zwischenschicht ein Dielektrikum verwendet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Dielektrikum ein Al-, Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxid verwendet wird.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine temperaturstabile Zwischenschicht verwendet wird.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht in einem Temperaturschritt stabilisiert wird.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zwischenschicht verwendet wird, die eine Diffusion im Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen oder metallhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozesses ermöglicht.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass nach Durchführung des Silizid-Prozesses die oberhalb der Zwischenschicht liegende metallische oder metallhaltige Schicht und gegebenenfalls auch die Zwischenschicht insbesondere durch zur Zwischenschicht selektives Ätzen entfernt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine temperaturinstabile Schicht verwendet wird, die sich in einem nachfolgenden, gegebenenfalls weiteren Temperaturschritt, insbesondere im Rahmen eines nachfolgenden, der Erzeugung der metallischen oder metallhaltigen Schicht dienenden Silizid-Prozesses zerstört.
11. Elektronisches Bauelement umfassend eine silizium- oder germaniumhaltige Schicht und eine nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 auf der silizium- oder germaniumhaltigen Schicht (3, 10, 14, 15, 20, 21, 27) hergestellte metallische oder metallhaltige Schicht (5, 12, 18, 24, 30).
12. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) eine Dicke von wenigen Atomlagen aufweist.
13. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) in einem ALD-Verfahren aufgebracht ist.
14. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) ein Dielektrikum ist.
15. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Dielektrikum ein Al-, Ta-, Hf-, Ti- oder Zr-Oxid ist.
16. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) durch einen Temperaturschritt stabilisiert ist.

17. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sich die metallische oder metallhaltige Schicht oberhalb, unterhalb oder beiderseits der Zwischenschicht (4, 11, 17, 23, 29) befindet.

5

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

FIG 4

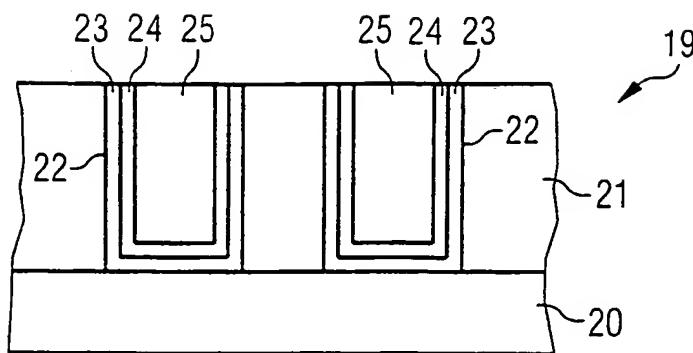


FIG 5a

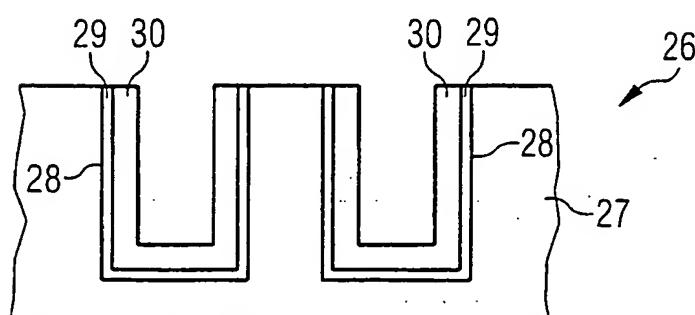


FIG 5b

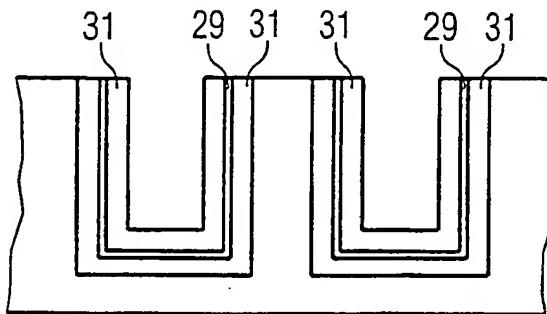


FIG 5c

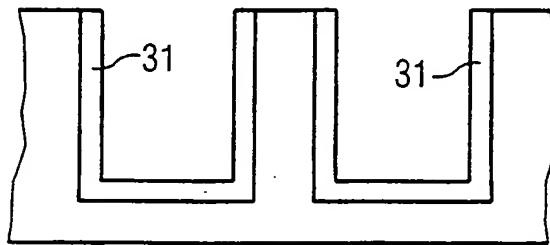


FIG 1

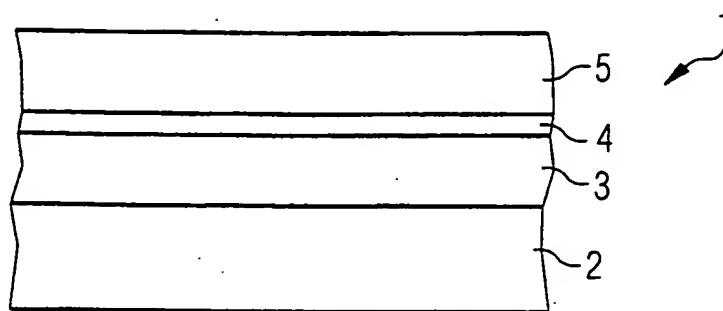


FIG 2

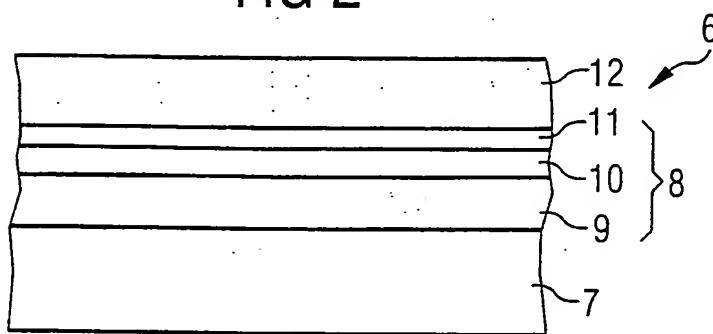


FIG 3

